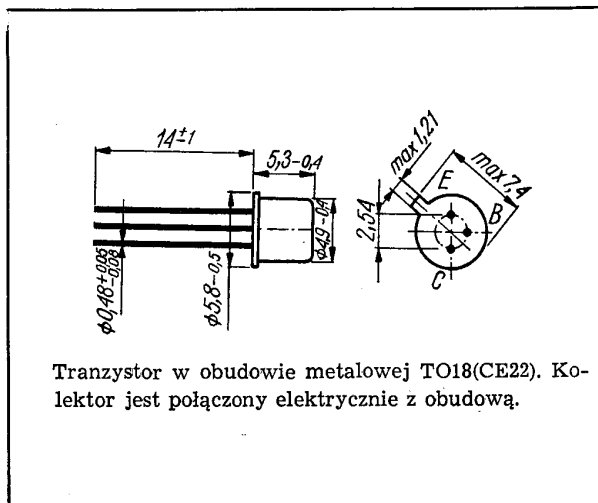


Tranzystor krzemowy epiplanarny przeznaczony do stosowania w układach szybko przełączających małej i średniej mocy.  
Kolektor tranzystora jest połączony elektrycznie z obudową.



Tranzystor w obudowie metalowej TO18(CE22). Kolektor jest połączony elektrycznie z obudową.

**DANE TECHNICZNE**

**Wartości dopuszczalne parametrów eksploatacyjnych**

Napięcie kolektor-baza	$U_{CB0}$	40	V
Napięcie kolektor-emiter	$U_{CE0}$	15	V
Napięcie emiter-baza	$U_{EB0}$	5	V
Prąd kolektora	$I_{CM}$	500	mA
Prąd bazy	$I_{BM}$	50	mA
Moc strat	$P_C$	360	mW
Temperatura złącza	$t_j$	423	K
		(150	°C)
Zakres temperatury otoczenia	$t_{amb}$	233...373	K
		(-40...+100	°C)

**Parametry statyczne**

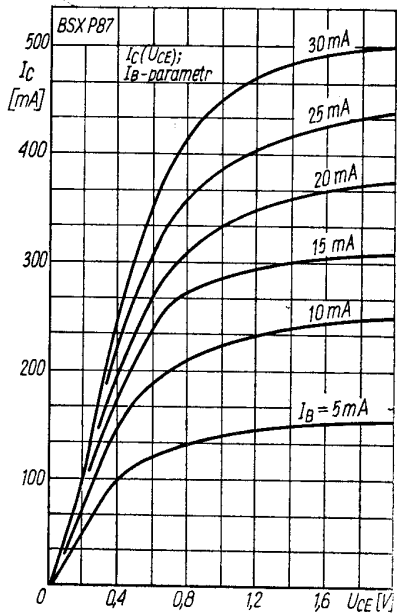
przy $t_{amb} = 298$ K (25°C)			
Napięcie przebicia kolektor-baza	$U_{(BR)CB0}$	<u>min. maks.</u>	
przy $I_{CB0} = 10 \mu A$		15	— V

Napięcie przebicia kolektor-emiter przy $I_C = 30$ mA	$U_{(BR)CE0}$	40	—	V
Napięcie przebicia kolektor-emiter przy $I_C = 30$ mA, $R_{BE} = 10 \Omega$	$U_{(BR)CER}$	20	—	V
Napięcie przebicia emiter-baza przy $I_{EB0} = 10 \mu A$	$U_{(BR)EB0}$	5	—	V
Prąd wsteczny kolektora przy $U_{CB0} = 20$ V	$I_{CB0}$	—	25	nA
przy $U_{CB0} = 20$ V, $t_{amb} = 373$ K (100°C)	$I_{CB0}$	—	8	$\mu A$
Prąd wsteczny emitera przy $U_{EB0} = 4$ V	$I_{EB0}$	—	100	nA
Napięcie nasycenia baza-emiter przy $I_C = 10$ mA, $I_B = 1$ mA	$U_{BEsat}$	—	0,85	V
Napięcie nasycenia kolektor-emiter przy $I_C = 200$ mA, $I_B = 20$ mA	$U_{CEsat}$	—	0,7	V
Współczynnik wzmocnienia prądowego przy $I_C = 10$ mA, $U_{CE} = 1$ V	$h_{21E}$	30	120	—
przy $I_C = 10$ mA, $U_{CE} = 1$ V, $t_{amb} = 233$ K (-40°C)	$h_{21E}$	15	—	—
przy $I_C = 500$ mA, $U_{CE} = 5$ V	$h_{21E}$	10	—	—

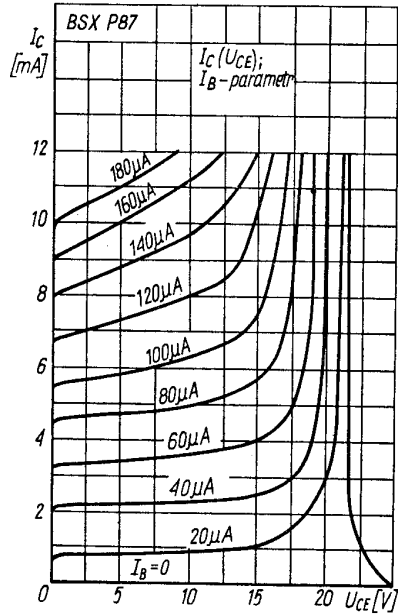
**Parametry dynamiczne**

przy $t_{amb} = 298$ K (25°C)				
Częstotliwość przeniesienia przy $I_C = 20$ mA, $U_{CE} = 10$ V	$f_T$	300	—	MHz
Pojemność kolektora przy $U_{CB0} = 10$ V	$C_C$	—	6	pF
Czas włączania przy $I_C = 200$ mA, $I_B = 40$ mA	$t_{ON}$	—	40	ns
Czas wyłączenia przy $I_C = 200$ mA, $I_{B1} = 40$ mA, $I_{B2} = -20$ mA	$t_{OFF}$	—	40	ns

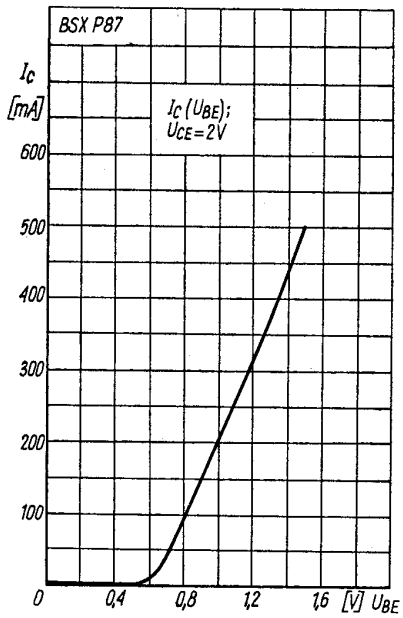
**SWW 1156-223**



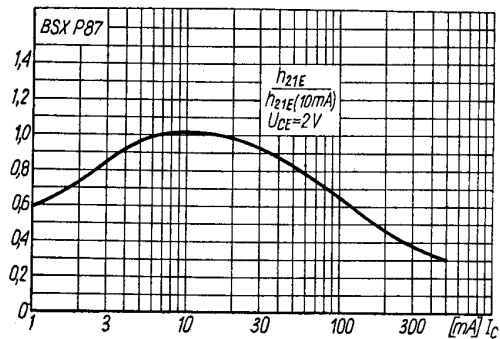
Charakterystyki wyjściowe  $I_C(U_{CE})$ ;  $I_B$  — parametr



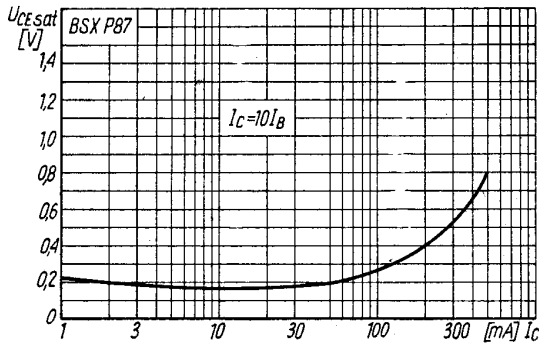
Charakterystyki wyjściowe  $I_C(U_{CE})$ ;  $I_B$  — parametr



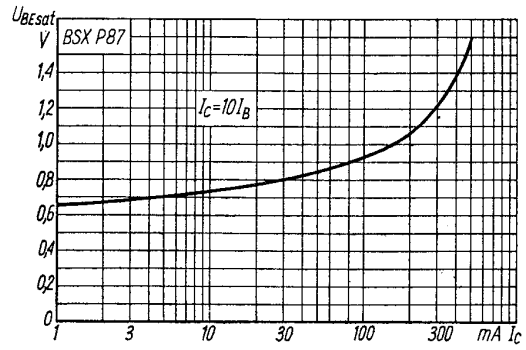
Charakterystyka przejściowa  $I_C(U_{BE})$



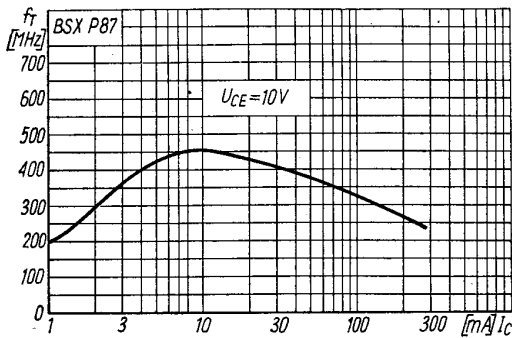
Zależność współczynnika wzmocnienia prądowego od prądu kolektora



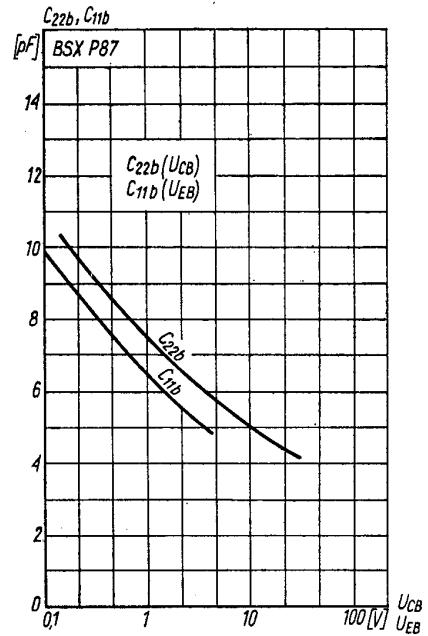
Zależność napięcia nasycenia kolektor-emiter od prądu kolektora



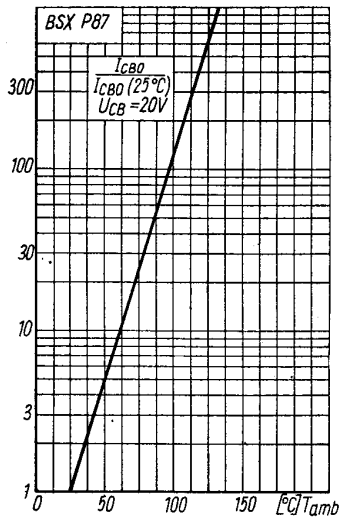
Zależność napięcia nasycenia baza-emiter od prądu kolektora



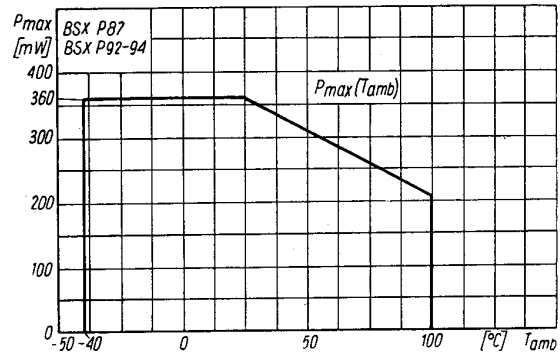
Zależność częstotliwości przenoszenia od prądu kolektora



Zależności pojemności kolektora i emitera od napięcia kolektora i emitera ;



Zależność prądu wstecznego kolektora od temperatury



Zależność dopuszczalnej mocy strat od temperatury otoczenia

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR



NAUKOWO-PRODUKCYJNE CENTRUM  
PÓLPRZEWODNIKÓW

Zakład Doświadczalny Półprzewodników przy ITE  
ul. Komarowa 5, 02-675 Warszawa  
telefon: 431431 do 39, telex: 813219